★電子デバイス研究会（ED）

専門委員長　前澤宏一　副委員長　津田邦男

幹事　松永高治・鈴木寿一　幹事補佐　新井　学・東脇正高

日時　10 月 22 日（木）　13：30～16：45

23 日（金）　9：00～12：15

会場　名城大学名駅サテライト（MSAT）（名古屋市中村区名駅 3-26-8　KDX 名古屋駅前ビル 13 階．JR 東海：名古屋駅から，ユニモール地下街 4 番出口を出てすぐ．http://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/msat.html　TEL〔052〕551-1666　村田英一）

議題　電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術

22 日

1. ダブルゲートスピント型エミッタの電極構造と電子ビーム軌道
   ○後藤康仁・辻　博司（京大）・長尾昌善（産総研）
2. 電子ビームプローブを用いた誘電体表面上の電荷密度分布の推定
   ○中島卓也・村田英一（名城大）・須原浩之（リコー）・下山　宏（名城大）
3. 電界集束型 FEA-HARP 撮像素子の放射電子特性
   ○本田悠葵・難波正和・宮川和典・久保田　節（NHK）・長尾昌善（産総研）・根尾陽一郎・三村秀典（静岡大）・江上典文（近畿大）
4. 静電レンズ一体型 Field Emitter Array の電子軌道解析―電流プロファイルの計算―
   ○後藤浩康・村田英一・下山　宏（名城大）
5. 計算機実験によるマグネトロンの寿命に関する研究
   ○平山啓太・三谷友彦・篠原真毅（京大）・川田浩平・桑原なぎさ（パナソニック）
6. 300 GHz 帯 MEMS-FWG-TWT の設計検討（その 2）
   ○蔦木邦夫・根尾陽一郎・三村秀典（静岡大）・藤下佑亮・吉田　満・松岡順一（NEC ネットワークセンサ）
7. テラヘルツ波帯における真空デバイスへの取組み
   ○吉田　満・岡本耕治・増田則夫・松岡順一（NEC ネットワークセンサ）・関根徳彦・菅野敦史・川西哲也・寶迫巌（NICT）

23 日

1. 貴金属表面拡散に通じ作製されたナノピラミッドへの銅フタロシアニンの吸着
   ○浅井泰尊・熊谷輝成・浅井大誠・加藤秀次・村田英一・六田英治（名城大）・大島忠平（早大）
2. 時間依存密度汎関数法によるカーボン系エミッタのフィールドエミッション電流の計算（第 1 報）
   ○樋口敏春・佐々木正洋・山田洋一（筑波大）
3. ボルケーノ構造を有するスピント型 Mo/Ni フィールドエミッタアレイの課題　　長尾昌善（産総研）
4. 高濃度窒素添加ダイヤモンドを用いた電子源の試作―鋳型成長を用いた電極一体・平板型エミッターの製作―
   ○胡谷大志（国際基督教大）・増澤智昭（静岡大）・山田貴壽（産総研）・岡野　健・斎藤市太郎（国際基督教大）
5. GaAs フォトカソードの表面活性過程と分光感度特性
   ○増澤智昭・光野圭悟・畑中義式・根尾陽一郎・三村秀典（静岡大）
6. シリコンフィールドエミッタの光応答性の評価
   ○嶋脇秀隆（八戸工大）・長尾昌善（産総研）・根尾陽一郎・三村秀典（静岡大）・若家冨士男・高井幹夫（阪大）
7. ナノ突起構造体の高さおよび原子配列の電界電離 He イオン電流に及ぼす影響
   ○永井滋一・加藤　習・岩田達夫・梶原和夫・畑　浩一（三重大）

◎22 日研究会終了後，懇親会を予定しますので御参加下さい．

☆ED 研究会今後の予定　〔　〕内発表申込締切日

11 月 26 日（木），27 日（金）　阪市大学術情報センター会議室〔未定〕テーマ：窒化物及び混晶半導体デバイス